

К ТЕОРИИ СВЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Л. Э. Гуревич, О. А. Мезрин

В [1] было исследовано электрическое поле (мы назовем его светоэлектрическим), возникающее в проводящей среде, в которой распространяются электромагнитные волны. Это поле обусловлено импульсом, передаваемым потоком электромагнитных волн свободным носителем.

Недавно появилась работа [2] по экспериментальному обнаружению светоэлектрической ЭДС в висмуте во внешнем магнитном поле. В настоящей работе мы подробнее исследуем влияние магнитного поля на этот эффект. При этом мы ограничимся случаем волн низкой частоты ω , удовлетворяющей условию $\omega\tau < 1$, где τ – время релаксации. В линейном по полю волны E_1, H_1 приближении кинетическое уравнение для поправки f_1 к равновесной функции распределения носителей имеет вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v \nabla f_1 + \frac{e}{mc} [vH] \frac{\partial f_0}{\partial v} + \frac{eE_1}{m} \frac{\partial f_0}{\partial v} = - \frac{f_1}{\tau} .$$

Откуда f_1 равна

$$f_1 = e\tau \frac{\left(\left[E_1 + \frac{e\tau}{mc} [E_1H] + \left(\frac{e\tau}{mc} \right)^2 H(E_1H) \right] v \right)}{1 + \left(\frac{e\tau}{mc} H \right)^2} .$$

Легко показать, что во втором по полю E_1, H_1 приближении можно не учитывать зависимости $\tau(\epsilon)$, где ϵ – энергия носителей; отброшенные члены при этом не дают вклада в светоэлектрический эффект. Тогда кинетическое уравнение для поправки

$$\frac{\partial f_2}{\partial t} + v \nabla f_2 + \frac{e}{mc} [vH] \frac{\partial f_2}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{e}{m} \operatorname{Re} \left\{ \left(E_1 + \frac{1}{c} [vH] \right) \frac{\partial f_1^*}{\partial v} \right\} = - \frac{f_2}{\tau} . \quad (1)$$

Рассматривая не слишком толстый образец, можно пренебречь членом $v \nabla f_2$. Подставляя в (1) f_1 , получим

$$f_2 = 4\pi \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{e^2 \tau^2}{mc^2} \frac{\left(\left[1 + \frac{1}{2} \frac{e\tau}{mc} \left\{ 3 + \left(\frac{e\tau}{mc} H \right)^2 \right\} [IH] + \left(\frac{e\tau}{mc} \right)^2 H(IH) \right] v \right)}{\left[1 + \left(\frac{e\tau}{mc} H \right)^2 \right]^2} ,$$

где I — плотность потока внутри образца. Вычисление плотности тока дает

$$j = \chi I + (\chi_1 + \chi_2 H^2) [I N] + \chi_3 N(I N), \quad (2)$$

где $\chi, \chi_1, \chi_2, \chi_3$ равны

$$\chi = A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{r^2}{[1 + (\Omega r)^2]^2} \epsilon^{3/2} d\epsilon; \quad \chi_1 = \frac{3}{2} A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{\frac{e}{mc} r^3}{[1 + (\Omega r)^2]^2} \epsilon^{3/2} d\epsilon,$$

$$\chi_2 = \frac{1}{2} A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{\left(\frac{e}{mc} \right)^3 r^5}{[1 + (\Omega r)^2]^2} \epsilon^{3/2} d\epsilon; \quad \chi_3 = A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{\left(\frac{e}{mc} \right)^2 r^4}{[1 + (\Omega r)^2]^2} \epsilon^{3/2} d\epsilon,$$

$$A = \frac{8\sqrt{2}e^3}{3\pi\hbar^3 m^{1/2} c^2}; \quad \Omega = \frac{eH}{mc}.$$

Формула (2) показывает, что в случае потока не параллельного магнитному полю компонента светозлектрического тока, пропорциональная их векторному произведению, состоит из двух слагаемых: одно из которых, характеризуемое коэффициентом $\chi_2 H^2$ больше первого в отношении $(\mu H/c)^2$ (где μ — подвижность), которое может быть значительным в сильном магнитном поле.

В ограниченном образце, не включенном в замкнутую электрическую цепь, возникает светозлектрическое поле, связанное с плотностью тока (2) соотношением

$$E = -\rho j - \rho_1 [j N] - \rho_2 N(j N), \quad (3)$$

где удельные сопротивления ρ, ρ_1, ρ_2

$$\rho = \frac{\sigma}{\sigma^2 + \sigma_1^2 H^2}; \quad \rho_1 = - \frac{\sigma_1}{\sigma^2 + \sigma_1^2 H^2}; \quad \rho_2 = \frac{\sigma_1^2 - \sigma_2 \sigma}{(\sigma^2 + \sigma_1^2 H^2)(\sigma + \sigma_2 H^2)}$$

$\sigma, \sigma_1, \sigma_2$ — соответственно проводимость, холловский и фокусирующий члены.

Используя (2) и (3), легко найти возникающее светозлектрическое поле, которое равно

$$E = \gamma I + \gamma_1 [I N] + \gamma_2 N(I N), \quad (4)$$

где светозлектрические коэффициенты $\gamma, \gamma_1, \gamma_2$ равны

$$\left. \begin{aligned} \gamma &= -\rho\chi + \rho_1(\chi_1 + \chi_2 H^2) H^2 \\ \gamma_1 &= -\rho(\chi_1 + \chi_2 H^2) - \rho_1\chi \\ \gamma_2 &= -\rho\chi_3 - \rho_1(\chi_1 H^2 + \chi_3) - \rho_2(\chi + \chi_3 H^2) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Из (5) следует, что коэффициент γ в сильном магнитном поле при $\mu H/c > 1$ не зависит от H .

При учете временной дисперсии решения для χ , χ_1 , χ_2 , χ_3 имеют вид

$$\chi = A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{r^2 [1 + (\omega^2 + \Omega^2) r^2]}{[1 + (\Omega r)^2] \{ [1 + (\Omega^2 - \omega^2) r^2]^2 + 4(\omega r)^2 \}} \epsilon^{3/2} d\epsilon,$$

$$\chi_1 = \frac{2}{3} A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{\frac{e}{mc} r^3 [1 + (\Omega^2 + \frac{1}{3} \omega^2) r^2]}{[1 + (\Omega r)^2] \{ [1 + (\Omega^2 - \omega^2) r^2]^2 + 4(\omega r)^2 \}} \epsilon^{3/2} d\epsilon,$$

$$\chi_2 = \frac{1}{2} A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \times \\ \times \frac{\left(\frac{e}{mc} \right)^3 r^5 [1 + (\Omega^2 - 3\omega^2) r^2]}{[1 + (\Omega r)^2] \{ [1 + (\Omega^2 - 3\omega^2) r^2]^2 + (\omega r)^2 [3 + (\Omega^2 - \omega^2) r^2] \}} \epsilon^{3/2} d\epsilon,$$

$$\chi_3 = A \int_0^{\infty} \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \frac{\left(\frac{e}{mc} \right)^2 r^4 [1 + (\Omega^2 + \omega^2) r^2]}{[1 + (\Omega r)^2] \{ [1 + (\Omega^2 - \omega^2) r^2]^2 + 4(\omega r)^2 \}} \epsilon^{3/2} d\epsilon.$$

Эти значения по порядку величины верны и в высокочастотном случае (когда $\omega r > 1$) для волн, скорость распространения которых порядка c .

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
18 октября 1971г.

Литература

- [1] Л.Э.Гуревич, А.А.Румянцев. ЖЭТФ, 53, 1144, 1967.
[2] М.С.Хайкин, А.Ю.Якубовский. ЖЭТФ, 60, 2214, 1971.